一种金属及半导体薄膜材料光学常数的标定方法

文献类型：专利

入库方式： OAI收割
来源：大连化学物理研究所

浏览	下载	收藏
78	0	0

其他版本

;

作者 邓淞文；李刚；孙龙

发表日期 2014

专利国别 CN

专利号 CN201210279625.7

专利类型 发明

权利人 中国科学院大连化学物理研究所

是否PCT专利 否

中文摘要 本发明涉及一种能够精确标定金属及半导体薄膜材料光学常数的方法。该方法适用于任何工艺制备的薄膜态金属和半导体材料，其流程如下：厚度为15-100nm薄膜样品制备；X射线全反射谱法精确标定厚度；透射率谱线及反射率谱线的测试；图形法求解光学常数。本方法与传统的光谱直接分析方法相比，能够解决金属及半导体薄膜厚度精确求解的问题，减少因厚度无法准确标定带来的误差，简化了求解过程，提高了光学常数求解的精度和速度。本方法具有广泛的适用性，能够为所有的涉及金属与半导体薄膜材料光学常数的科学与工程问题提供准确的参考数据。

公开日期 2014-02-12

申请日期 2012-08-07

语种 中文

专利申请号 CN201210279625.7

源URL [http://159.226.238.44/handle/321008/120675]

专题 大连化学物理研究所_中国科学院大连化学物理研究所

推荐引用方式 GB/T 7714 邓淞文,李刚,孙龙. 一种金属及半导体薄膜材料光学常数的标定方法, 一种金属及半导体薄膜材料光学常数的标定方法. CN201210279625.7. 2014-01-01.

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。